

Trias 企業メモ 2011-02-25

(6920 JASDAQ)レーザーテック株式会社
2011年6月期 第2四半期決算説明会サマリ

2011年2月2日開催のレーザーテック株式会社(以下、レーザーテック)の2011年6月期第2四半期決算説明会に基づく決算概要をご案内いたします。

【2011年6月期 第2四半期累計期間 連結決算概要】

【表1】にある通り、2010年6月期 第2四半期累計期間(FY6/11 上期)の連結売上高は、前年同期比14.8%増の4,200百万円、営業利益245百万円となった(前年同期は80百万円の赤字)。また、2月2日付予想に対しては、売上高で400百万円、営業利益で595百万円、上回る結果となった。

【表1】連結決算概要 ※各表とも、レーザーテック(株)の開示データに基づき、(株)トリアスにて作成

連結 (百万円)	FY6/10 上期		FY6/11 上期			対前期同期		対予想 増減額
	実績	構成比	予想	実績	構成比	増減額	増減率	
売上高	3,660	100.0%	3,800	4,200	100.0%	540	14.8%	400
売上総利益	1,270	28.6%	n.a.	1,620	38.1%	350	27.6%	n.a.
販管費及び一般管理費	1,351	35.7%	n.a.	1,374	29.8%	23	1.7%	n.a.
営業利益	△ 80	-7.1%	△ 350	245	8.4%	325	n.a.	595
経常利益	△ 61	-7.1%	△ 400	141	8.0%	202	n.a.	541
当期純利益	△ 96	-7.0%	△ 250	73	4.0%	169	n.a.	323
研究開発費	494	13.5%	n.a.	415	9.9%	△ 79	-16.0%	n.a.
減価償却費	176	n.a.	n.a.	140	n.a.	△ 36	-20.5%	n.a.
設備投資額	6	n.a.	n.a.	15	n.a.	9	150.0%	n.a.
従業員数(除 役員)	235	n.a.	n.a.	232	n.a.	△ 3	-1.3%	n.a.

【表2】製品別 売上高・受注動向

連結 (百万円)	FY6/10 上期			FY6/11 上期					FY6/11 下期	
	受注高 (実)	売上高 (実)	受注残高 (実)	受注高 (予)	受注高 (実)	売上高 (予)	売上高 (実)	受注残高 (実)	受注高 (予)	受注残高 (予)
半導体関連装置	2,433	1,905	2,042	6,380	4,153	2,560	1,893	3,452	7,147	6,100
FPD関連装置	704	1,079	3,191	2,350	1,822	570	1,626	4,263	378	1,700
レーザー顕微鏡	211	154	103	200	288	200	110	188	112	10
サービス	551	520	143	470	578	470	571	162	522	150
合計	12,054	3,660	5,481	9,400	6,842	3,800	4,200	8,066	8,158	7,960

予想を上回った背景には、FPD 関連装置のうち、大型マスク検査装置とそのオプション売上が前倒しになったことがある。【表2】からも分かるとおり、今上期について、半導体関連装置売上はほぼ前年並みであったが、対前期同期で受注高、受注残が大きく伸長しているが、これには前年度発表の新製品が寄与している。最も大きく寄与しているのが、フォトマスク用パターン欠陥検査装置 MATRICES X700 シリーズ。受注も順調で、既に日本、台湾、韓国、欧米と、グローバルに出荷が始まっている。ハイパワーIC用 SiC(炭化ケイ素)ウエハのプロ

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

セス工程での欠陥を検査する装置 SICA61 についても、複数台を販売した。この装置は、レーザーテックのコア技術であるコンフォーカル光学技術を活用し、透明基板である SiC ウェハ裏面の反射光の影響を受けない検査方法を実現した。微小な欠陥を検出できるという差別化技術により、顧客から高い評価を受けている。この他、膜厚ムラ検査装置 MR300 (WASAVI シリーズ) に対しても受注が入り始めた。この装置は、CCD や CMOS イメージセンサの感度ムラ要因となる膜厚不均一性を高精度に検査するもので、大手 CCD/CMOS イメージセンサメーカーからの引き合いが強くなっている。さらに、太陽電池の変換効率分布測定器 MAP シリーズについても、累計受注台数が 2 ケタになった。

財務面では、利益増に伴い現預金が前年度末比 1,010 百万円増加、ならびに受注増に伴い仕掛品が同 1,001 百万円増加した。また、2010 年 12 月に新株予約権付社債 4,000 百万円が償還したことより、シンジケートローンを実行。その結果、流動負債が減少する一方、固定負債が増加した。ちなみに、今上期末の有利子負債残高は、前年度末比 944 百万円増の 4,944 百万円となった。キャッシュフローについては、受注増により、たな卸資産や未収入金が増加したことから、営業活動によるキャッシュフローが前年同期の 754 百万円から 262 百万円に減少。これにより、フリーキャッシュフローが同 735 百万円から 249 百万円に減少した。

【2011 年 6 月期 通期業績予想】

市場環境について、半導体市場は、タブレット PC やスマートフォンといった代替アプリケーションの登場で、NAND フラッシュメモリを中心に、堅調に推移している。また、エコ・省エネ関連のパワーデバイスを中心とするディスクリート半導体に対する需要も拡大している。DRAMについては、PC 需要の低迷から、足元、価格が著しく低下している。

半導体メーカーの設備投資動向については、大手のメモリーメーカー、ファンドリが、微細化・増産目的の大型設備投資を実施。一部東アジアのデバイスメーカーが、ロジック半導体のファンドリビジネスを開始するといった動きも出てきている。レーザーテックでは、2011 年についても、勝ち組を中心に、メモリーメーカー、ロジックメーカー、ファンドリによる投資が継続すると予想している。また、パワーデバイスや CMOS イメージセンサなどの投資についても拡大すると見ている。

一方、FPD 市場については、大型パネルを中心に生産調整が続き、2011 年は投資の抑制が予想される。そのような環境下、中国 CSOT を中心とした第 8 世代(8G)の投資、また、中国政府から認可がおりた韓国の三星、LG ディスプレイによる工場立上げや、タブレット PC などに使われる中小型高精細 TFT、アクティブ型有機 EL 向け投資が見込まれる。太陽電池市場では、欧州をはじめ、日本、アメリカにおいて市場が急拡大しており、日本以外のアジアのパネルメーカーが台頭してきている。設備投資は、短期的には、補助金などの各国の支援により左右されることが予想されるが、中長期的には拡大していくとレーザーテックでは予想している。

このような市場環境前提に基づくレーザーテックの通期業績予想だが、【表 3】にあるとおり、2 月 2 日付の期初予想に変更は無い。上期に引き続き、成長拡大市場における新規事業開拓、ならびにレーザーテックの強みを活かした差別化製品による市場シェア拡大を基本戦略の 2 軸に置き、前者は太陽電池や SiC ウェハ関連、後者

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

はフォトマスク欠陥検査装置 MATRICS X700 シリーズを中心に、下期の計画達成を目指す。受注については、【表 2】に見られるとおり、半導体関連装置を大きく伸ばす一方、FPD 関連装置については減少傾向を見込む。この他、研究開発費について、下期に 1,008 百万円と、上期対比倍増の計画だが、次世代機、新しいビジネスチャンス開拓のための投資を積極化すると、期初のスタンスを変えず、実行していく。

【表3】連結業績予想

連結 (百万円)	FY6/10		FY6/11予				対前年通期	
	実績	構成比	上期(実)	下期	通期	構成比	増減額	増減率
売上高	8,931	100.0%	4,200	8,300	12,500	100.0%	3,569	40.0%
半導体関連装置	5,142	57.6%	1,893	4,507	6,400	51.2%	1,258	24.5%
FPD関連装置	2,432	27.2%	1,626	2,974	4,600	36.8%	2,168	89.1%
レーザー顕微鏡	369	4.1%	110	290	400	3.2%	31	8.4%
サービス	986	11.0%	571	529	1,100	8.8%	114	11.6%
営業利益	746	8.4%	245	1,155	1,400	11.2%	654	87.5%
経常利益	714	8.0%	141	1,159	1,300	10.4%	586	82.0%
当期純利益	361	4.0%	73	777	850	6.8%	489	135.1%
研究開発費	924	10.3%	415	1,008	1,423	11.4%	499	54.0%
減価償却費	354	n.a.	140	178	318	n.a.	△ 36	-10.2%
設備投資額	27	n.a.	15	65	80	n.a.	53	196.3%
従業員数(除 役員)	229	n.a.	232	235	235	n.a.	6	2.6%

※予想は2月2日付会社発表のもの

上期は、透明ウェハ欠陥検査レビュー装置 TROIS(トロワ)32 (WASAVI シリーズ)と、同じく WASAVI シリーズのリソグラフィプロセス検査装置 LP300 の 2 機種の新製品を発表した。TROIS32 は、LED、レーザーダイオード、ハイパワーデバイスなどに用いられる GaN(窒化ガリウム)、サファイア等の透明基板向け製品で、前述の SICA61 同様、透明基板の裏面の反射光の影響を受けずに欠陥検出ができるという特徴を持つ。LP300 は、フラッシュメモリや DRAM 等、ArF 液浸などの先端リソグラフィ工程を行う市場向けの製品で、現像後のレジストの膜厚ムラや CD エラーなどを検出する装置となっている。

次世代向け新製品開発としては、微細な欠陥を迅速に検査するための半導体用マスク検査装置、及び EUVL (極端紫外線露光)用マスク blanks 欠陥検査装置の次世代機を継続して開発している。また、2011 年 1 月に、レーザーテックの強みが発揮でき、かつ同社がまだ参入していない市場での事業開拓に特化した組織として、先端開発室を新設した。

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

【決算説明会 Q&A】

Q. 今年 1 月以降、一部大手半導体メーカーが設備投資を活発化するなど、変化が現れている。この動きは、御社業績にどのようなインパクトを与えるか？また、この急激な変化は、今期予想にどの程度、織り込まれているのか？

A. まず、半導体のマスクブランクスについては、微細化の流れの中で、メモリーメーカー、ファンドリに、微小な欠陥を検出するニーズが拡大している。このため、デバイスメーカーから、マスクメーカーやマスクブランクスメーカーに向けてのプレッシャーが強まっており、微細な欠陥検出ニーズの広がりは今後とも継続すると見ている。一方、マスクパターン検査装置については、従来の MATRICS X600 シリーズはメモリーに強かったが、今回市場に出した X700 シリーズは、ロジックファンドリに納めさせていただき、当社のノウハウも蓄積されてきていることから、メモリー・ロジック双方の市場をターゲットに考えている。2010 年はメモリーメーカーによる投資が中心であったが、今年 2011 年は、ファンドリによる新規ファブ投資、既存ファブ増強が計画されている。このような投資動向をどの程度今期業績予想に織り込んでいるかについてだが、年度末にかけての案件で、口頭による内示で注文書が出ていない案件などもあり、それらの出荷が第 3-4 四半期に集中、売上げ計上は第 4 四半期に集中している。このため、第 4 四半期に見込まれる案件の業績予想への織り込みは慎重に行っている。

Q. 新製品動向について、次世代 EUVL 向けマスクブランクス検査装置、今年から商業出荷が始まる TSV (シリコン貫通電極) 関連装置についての見通しは？また、液晶関連では、アクティブ型有機 EL 関連の投資が拡大することだが、御社の取組みは？

A. EUVL については、過去 1 年くらいの間に大きな変化があり、主要デバイスメーカーの 2012-2013 年の量産化スケジュールが見えてきた。これに伴い、マスクブランクスメーカーへのプレッシャーが強まり、当社への引き合いも増えてきている。当社としては、マスクブランクス市場をターゲット市場と捉えている。TSV 関係では、米国 SEMATECH (米国半導体工業会が中心となり発足したコンソーシアムで、世界の主要メーカーが技術開発に参画している) に TSV エッチング深さ検査装置 TSV-300IR (WASAVI シリーズ) を出しており、今後引き合いが増えると考えている。液晶関連については、従来大型マスク検査装置の製品化を進めてきたが、今後は中小型用マスクを検査したいというニーズが増えてくるとの予想はしている。

Q. SiC や TSV などの新製品のニッチな領域における競合状況は？

A. SiC については従来装置がある。小口径のシリコンウェハ向けにレーザー散乱光を使った装置であるが、これは透明な基板には向かない。このため、当社のコンフォーカル技術を使った装置に代替される流れになっている。TSV については、当社は赤外線を使っているが、口径が小さくて深いホールまで測定できるという特徴を持っており、その点が SEMATECH でも評価された。

Q. FPD 関連装置の中小型パネル向け受注動向は？

A. 中小型に関しては、タッチパネル向けにマスク使用量が増えてきていて、マスク検査装置への引き合いが若干見られるようになってきた程度。大型マスク検査装置については、中国の BOE や TCL の量産が始まれば、8G 以降の投資に期待ができる。

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

Q. 製品別売上高・受注高の内訳について？

A. 上期実績・通期予想の内訳は以下のとおり：

売上高・受注高(百万円)	FY6/11 上期(実)		FY6/11 通期(予)	
	売上高	受注高	売上高	受注高
半導体関連装置	1,893	4,153	6,400	11,300
：マスク検査装置(MATRICES)	約90%	80%強	80%弱	70%強
：マスクブランクス検査装置(MAGICS)	約10%	-	10%	20%
：新製品		約20%	10%	10%弱
FPD関連装置	1,626	1,822	4,600	2,200
：カラーフィルター修正装置	約60%	約80%	75%強	75%
：大型マスク検査装置等	約40%	約20%	25%弱	25%
（うち太陽電池関連）	(1億円弱)	-	(R&D用に 引き合いで 2億円弱)	(一部あり)

なお、期初予想による通期受注高の内訳は、半導体関連が10,500百万円、FPD関連が3,560百万円であったが、FPD関連の下方修正は、中国を中心とした投資が遅れていること、ならびに競争激化で受注がとれにくくなっている現状を織り込んだ。一方で半導体関連は、半導体メーカーを中心に、当社マスク検査装置に対する評価が上がってきており、受注も拡大してきていることによる上方修正。

【ご参考： 中期トレンドを見る】

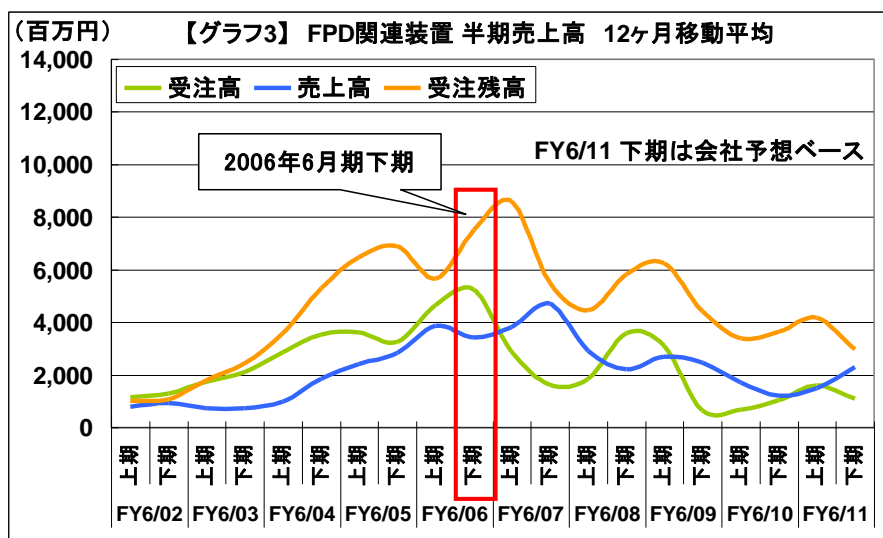
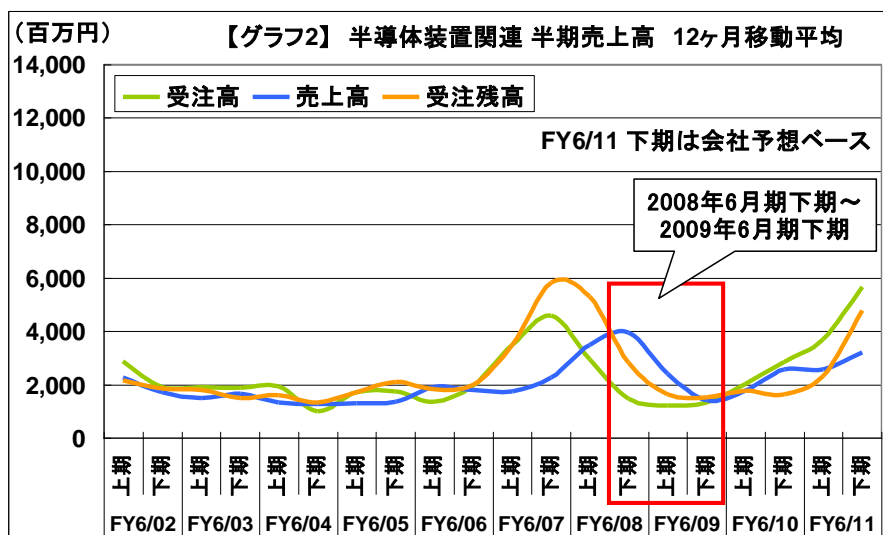
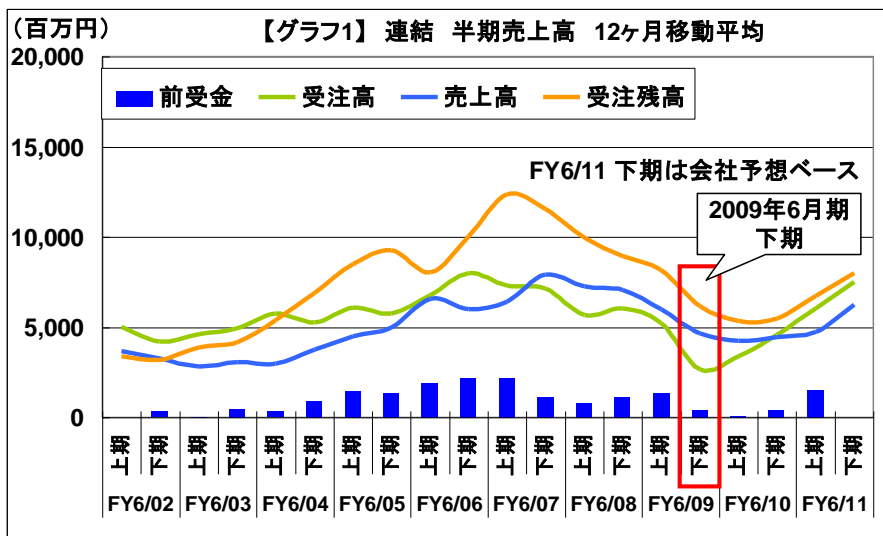
レーザーテックでは最終検収ベースでの売上計上基準を採用しているため、受注から売上計上までのリードタイムが比較的長い。半導体関連で平均して6-9ヶ月、液晶関連の装置になると1年以上のリードタイムになる場合もある。このため、同社事業を理解するには、売上高・受注の中期トレンドを追う必要がある。このため、受注や売上トレンドを12ヶ月移動平均で見たいと思う。

次頁【グラフ1】で、レーザーテック業績の先行指標になるとと思われる受注高の推移を見ると、2009年6月期の下期を底に、V字回復を見せている。売上高の戻りはなだらかだが、1年ほどのラグをもって、受注高のトレンドを追いかける形になっているが、この戻りを牽引しているのが、【グラフ2】にある半導体装置関連のトレンドだ。受注高のトレンドは、2008年6月期下期から2009年6月期の下期まで底ばい、その後徐々に拡大基調に入っている。

受注高は2007年6月期下期のピークの水準を更新、それを追うように受注残高の水準もピークを更新しつつある。一方、【グラフ3】のFPD関連装置については、2006年6月期下期をピークに受注高トレンドは下降トレンドに入り、現在も低迷状態から抜け出していない模様。

今後の見方としては、新製品開発を強化している半導体装置関連の受注高が前回ピークを更新した現水準を維持できるかが重要と思われる。同社の中期的成長を考える上で、今下期の計画達成、また来期に向けての受注拡大の実現が極めて重要な局面にきていると考えられる。📈

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。



このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。

【ご参考】

(6920)レーザーテック株式会社

連結主要指標と業績の推移

連結主要データ		
発行済み株式数(株)	2010.12月	11,785,800
うち自己株式数(株)	2010.12月	522,727
時価総額(百万円)	2011.2.25	12,941
一株当純資産(円)	2010.12月	1,058.5
ROE(%)	2010.12月	△ 5.2
ROA(%)	2010.12月	△ 3.1
PER(倍)	2011.6月予	14.6
PCFR(倍)	2010.12月	△ 71.9
PBR(倍)	2010.12月	1.0
株価(円)	2011.2.25	1,098
単元株数	2010.12月	100
日々平均出来高	2011.2.25	25,151

連結主要データ		
総資産(百万円)	2010.12月	19,867
自己資本(百万円)	2010.12月	11,922
有利子負債(百万円)	2010.12月	6,100
自己資本比率(%)	2010.12月	60.0
有利子負債比率(%)	2010.12月	51.2
フリーキャッシュフロー(百万円)	2010.12月	△ 1,726

注: ROE=当期純利益÷期末自己資本

ROA=当期純利益÷期末総資産

PCFR=時価総額/(当期純利益+減価償却費)

日々平均出来高=過去1年間の平均

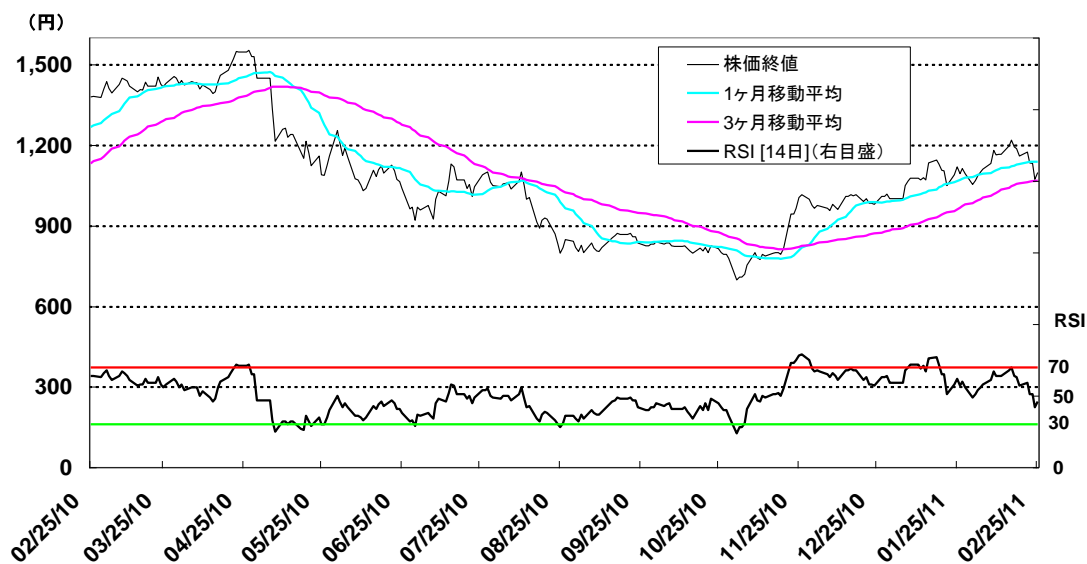
有利子負債比率=有利子負債÷自己資本

フリーキャッシュフロー(FCF)=営業CF+投資CF

連結(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益	一株益(円)	一株配(円)
2006年6月期	12,033	2,963	3,060	1,884	162.3	40.00
2007年6月期	15,874	3,895	3,895	2,375	203.8	60.00
2008年6月期	14,136	3,100	3,156	1,888	165.2	50.00
2009年6月期	9,266	△ 657	△ 659	△ 651	△ 57.8	15.00
2011年6月期第2四半期	4,200	245	141	73	6.5	0.00
予2011年6月期	12,500	1,400	1,300	850	75.5	23.00

注 2011年6月期予想は、2011年2月2日発表の会社予想

株価チャートとRSI



出所: BloombergのデータをもとにTrias作成

注: RSI(Relative Strength Index)とは株価の「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」を指数で表したもので、一般的にRSIが70を超えると高値圏、30以下では安値圏に位置していると言われている

RSI= N日間の値上がり幅平均÷(N日間の値上がり幅平均+N日間の値下がり幅平均)×100

このメモは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。このメモに記載されている内容は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容・意見は当該説明会時、ならびに/あるいは取材時における判断であり、今後、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に際しての最終決定は投資家の皆さまご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。